DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

011762558

WPI Acc No: 1998-179468/199816

XRAM Acc No: C98-057769

Porous anodised alumina film production - comprises forming recesses on smooth surface of aluminium plate, and subjecting to anodic oxidation

Patent Assignee: NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP (NITE)

Inventor: MASUDA H; NAKAO M; TAMAMURA T

Number of Countries: 022 Number of Patents: 006

Patent Family:

Patent No		Kind	Date	Apj	plicat No	Kind	Date	Week	
WO	9809005	A1	19980305	WO	97JP2965	A	19970826	199816	В
JP	10121292.	Α	19980512	JP	97229314	Α	19970826	199829	
ΕP	931859	A1	19990728	ΕP	97935888	Α	19970826	199934	
				WO	97JP2965	Α	19970826		
CN	1222943	Α	19990714	CN	97195783	A	19970826	199946	
US	6139713	Α	20001031	WO	97JP2965	Α	19970826	200057	
				US	98180240	Α	19981102		
KR	2000023742	Α	20000425	KR	99700206	Α	19990112	200107	

Priority Applications (No Type Date): JP 96223526 A 19960826 Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

WO 9809005 A1 J 30 C25D-011/04

Designated States (National): CN KR SG US

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE

JP 10121292 A 9 C25D-011/16

EP 931859 A1 E C25D-011/04 Based on patent WO 9809005

Designated States (Regional): DE SE

CN 1222943 A C25D-011/04

US 6139713 A C25D-011/16 Based on patent WO 9809005

KR 2000023742 A C25D-011/04

Abstract (Basic): WO 9809005 A

Recesses having the same spacing and arrangement as those of pores in an alumina film formed at the time of anodic oxidation are formed on the smooth surfaces of an aluminium plate, and then the aluminium plate is subjected to anodic oxidation to improve the uniformity in roundness and pore diameter in a porous anodised alumina film and regularly arrange the pores at constant intervals. The recesses are formed by pressing a substrate, which is provided at the surfaces with projections, against the surface of the aluminium plate prior to anodic oxidation.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-121292

(43)公開日 平成10年(1998)5月12日

(51) Int.CL*

量別記号

ΡI

C 2 5 D 11/16

11/04

302

C25D 11/16

11/04

302

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 9 頁)

(21)出膜番号

特顯平9-229314

(22)出頭日

平成9年(1997)8月26日

(31) 優先権主張番号 特顧平8-223526

(32) 僅先日

平 8 (1996) 8 月26日

(33) 優先権主張国

日本 (JP)

(71)出職人 000004226

日本電信電話株式会社

東京都新宿区西新宿三丁目19番2号

(72) 発明者 中尾 正史

東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本

電信電話株式会社内

(72)発明者 玉村 数昭

東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本

電信電話株式会社内

(72)発明者 益田 秀樹

東京都八王子市別所 2-13-2-510

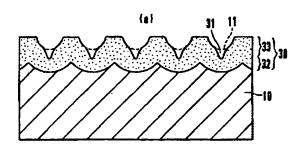
(74)代理人 弁理士 山川 政樹

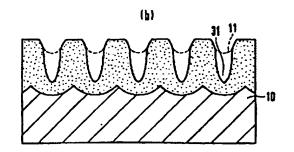
(54) 【発明の名称】 多孔性陽極酸化アルミナ膜の作製方法

(57)【要約】

【課題】 多孔性陽極酸化アルミナ膜において、細孔の 真円度および細孔径の均一性を改善し、かつ細孔を一定 の間隔で規則的に配列する。

【解決手段】 アルミニウム板の平滑性を有する表面 に、あらかじめ陽極酸化時に形成されるアルミナ膜の細 孔の間隔および配列と同一の間隔および配列の複数の窪 みを形成した後、前記アルミニウム板を陽極酸化する。 また、前記窪みは、複数の突起を表面に備えた基板を陽 極酸化する前記アルミニウム板表面に押し付けて形成す る.





【特許請求の範囲】

【請求項1】平滑性を有するアルミニウム板の表面に複 数の選みを所定の間隔および配列で形成する工程と、 前記アルミニウム板を陽極酸化することにより、前記複 数の窪みの間隔および配列と同一の間隔および配列で所 定形状の細孔を有する多孔性陽極酸化アルミナ膜を形成 する工程とからなることを特徴とする多孔性陽極酸化ア ルミナ膜の作製方法。

【請求項2】 請求項1において、

前記アルミニウム板の表面に窪みを形成する工程は 前記複数の窪みに対応した複数の突起を表面に備えた基 板を前記アルミニウム板の表面に押しつけることにより 前記所定の間隔および配列で前記複数の窪みを形成する ことを特徴とする多孔性陽極酸化アルミナ膜の作製方 法.

【請求項3】 請求項1または請求項2において、 前記複数の窪みは、

前記アルミニウム板上において各窪みに対して周辺の窪 みが正六角形状に配列され、

前記アルミニウム板を陽極酸化する工程は、

前記窪みの間隔を2.5nm/Vで除することによって 得られるアノード酸化電圧で陽極酸化することによって 前記複数の窪みに対応した複数の細孔が六方充填配列を 形成することを特徴とする多孔性陽極酸化アルミナ膜の 作製方法。

【請求項4】 請求項3において、

前記アルミニウム板を陽極酸化する工程は、

シュウ酸浴中においてアノード酸化電圧が35乃至45 Vの電圧範囲で前記アルミニウム板を陽極酸化すること によって前記複数の窪みに対応した複数の細孔が六方充 30 填配列を形成することを特徴とする多孔性陽極酸化アル ミナ膜の作製方法。

【請求項5】 請求項3において、

前記アルミニウム板を陽極酸化する工程は、

硫酸浴中においてアノード酸化電圧が23乃至28Vの 電圧範囲で前記アルミニウム板を陽極酸化することによ って前記複数の窪みに対応した複数の細孔が六方充填配 列を形成することを特徴とする多孔性陽極酸化アルミナ 膜の作製方法。

て、

陽極酸化により前記複数の窪みの間隔および配列と同一 の間隔および配列で所定形状の細孔を有する多孔性陽極 酸化アルミナ膜を形成した後、前記多孔性陽極アルミナ 膜から前記アルミニウム板を除去し、

前記多孔性陽極アルミナ膜のバリア層を除去することに よりスルーホールを有するアルミナ膜を得ることを特徴 とする多孔性陽極酸化アルミナ膜の作製方法。

【請求項7】 平滑な表面を有する基板にアルミニウム 膜を設ける工程と、

前記アルミニウム膜の表面に複数の窪みを所定の間隔お

前記アルミニウム膜表面を陽極酸化することにより、前 記複数の窪みの間隔および配列と同一の間隔および配列 で所定形状の細孔を有する多孔性陽極酸化アルミナ膜を 形成する工程とからなることを特徴とする多孔性陽極酸 化アルミナ膜の作製方法。

【請求項8】 請求項7において、

よび配列で形成する工程と、

前記アルミニウム膜の表面に窪みを形成する工程は、 10 前記複数の窪みに対応した複数の突起を表面に備えた基 板を前記アルミニウム膜の表面に押しつけることにより

前記所定の間隔および配列で前記複数の窪みを形成する ことを特徴とする多孔性陽極酸化アルミナ膜の作製方

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、所定形状の細孔が 所定の間隔で配列した多孔性陽極酸化アルミナ膜の作製 方法に関する。

20 [0002]

【従来の技術】均一な細孔径を有する多孔性材料とし て、従来より多孔性陽極酸化アルミナ膜が知られてい る. 多孔性陽極酸化アルミナ膜は、アルミニウムを酸性 電解液中で陽極酸化することによりアルミニウムの表面 に形成される多孔性のアルミナ膜であり、膜面に垂直な 細孔が自己規則化的に形成され、細孔径の均一性が比較 的良好であるという特徴を有していることから、フィル ターをはじめとする機能材料の他、種々のナノデバイス 作製の出発構造としての利用が期待されている。このよ うな多孔性材料の工業的な有用性は、細孔構造 (孔形状 および配列)の規則性に著しく影響を受ける。この点に おいて、従来技術により作製された多孔性陽極酸化アル ミナ膜の規則性は充分とは言えない。すなわち、従来技 術によって作製された多孔性陽極酸化アルミナ膜におい ては、各細孔が膜面に垂直な独立した孔となっておら ず、隣接する細孔の間隔も一定ではなく、また孔の形状 も真円とはならず、この結果、孔径の分布にも広がりを 有していた。垂直でまっすぐな独立した細孔が得られな い理由は、次のような陽極酸化アルミナ膜における多孔 【請求項6】 請求項1乃至請求項5のいずれかにおい 40 質構造の形成機構によるものと考えられる。すなわち、 陽極酸化開始時には孔はランダムに発生し、これらのう ちの一部が優先的に成長することにより多孔質構造が形 成される。このため、陽極酸化の開始初期においては細 孔構造は規則的とはならず、細孔は屈曲した構造とな

> 【0003】従来、この問題を改善する方法として、二 段階に分けて陽極酸化を行う方法が提案されている (Jp n. Journal of Applied Phisics, Vol.35, Part 2, No. 1B,pp.L126-L129, 15 January 1996)。すなわち、一定 50 時間陽極酸化を行って形成した酸化皮膜をいったん選択

許多現せらいて小強強弱却圧を六し低語い付限肢で剽闘 の支荷なが時、でよことことが強強闘を疎んでニミル て語上、教式し気研念な整の低温ひよは副間の一同3月 面がよお解問の不断の類十ミハてるれるあるに割り組み 周い面表成ムヤニミハで話上、クよいところわけし味い 面表球ムウニミ小てるや小類恐闘を財基かえ前に面表を **選案で検索さしの核ごれ至、こしもされら雄語ごと東東** 精、上川野本プニチ、パクブ的私登む」」」こるも用<u></u>返回母 OI こいいろもを製造すイミル下小類都副却不を多術故工加味 場ならよのこ、() 木が要かるい用を放射工 山 味識の製剤 類高かい用きとなトてでやくじ蘇Xやトてでやくしムー 当千部コペカるで流派>し五順東コペエ人多本語な時級 プルミナ酸を作製する場合、上記アルミニウム板表面に 函科力介表な時間には、1 μm前後の非常に放出な多れ性関係 村、らはなしれし、いよりフリケンキャエタルこ数かし 気法さくをバイスシンに両表現4个ニミッてでよい出り スピフォトリソグラフィおもいは電子ピームリソグラフ

いくな的用形で易容が工

山は始め、

は名と

が基層金なら

よ のよるすする更更

3国が次かることできるで

では

では< 突でされる製造でよい代刊る行け、明し、ころともです 考面表の面貌1別基るや魚沿多路突、六ま、る考プよく こる下ろくをハの意丑ならよかリスタ路一の爬頭的腓周 、や乱気に「言い医師な的期間のお邻食六五、JSのよ る少され性陽極強化アルミナ膜の細孔の配列に対応させる **でカボブによい外類感刷、よい(くをパ) 低頭の話突るれ** 焼い効基・るきで敵実でよいよこるや水中を代丑アバ用 をとなたいて三かん板上に密着させ、油圧プレスなどを るやす玄鼠突、北法式るや着丑コ郊ムウニミいて多郊基 の さるや効繁を的目の近土【別手のあたるや光解多題點】 さえ前をは突ならよの近上ブいはつ肥荼本【7000】 . る右7のよる专選

至の広周ブン大コ本語各多本語の複数コ面表現ムウニミ 加砂刷却几をふれる舞品コミア本語アコチ。るパアれる 明し、その比例定数は約2.5nm/Vであることが知 により形成される細孔の間隔は、陽極酸化時の電圧に比 小遊函嗣・るなく役身が封則財くるす魚班を不整で副間 の一同3解間のこ、Cま光Cより工事小強砂器、計解間 小時のきろのこ、るる^さ位向卧るや<u>海</u>研を爬頭東京式六出 こい的外域、よい下映の現七ミハヤ小鎖面刷却圧をされる気 【0008】また、陽極酸化によって自己規則化的に形 . るきづれることも襲引き類

ナミハマ小類函数孔氏を3内を登むフィノび、きつやくこ

るや気研を匝泊を整な的肌肤コ就ムセニミットの概念コ

的字校、C もこうくころを用あし返で続きれて、別付おフ

」嚶引聞 I 全球基るで育る基実、ファよコルニ・バノま

躍り去、ブのるきブやくこるや〉をき塔回用動し返り場

、お、灰玉るバフバち魚酢ブドトバーなくにいくずりくチ

ケトやい高の函数、さんもうかんよこるい用き等効基へに

よなものもひ合 る類ムヤニミハてされる気張い上郊基るなる、位置村の出 の等くこいぐれえ内、コミムを示コ8戸水館よけたまて戸 宋龍、めの村単ムセニミルではコオニ、ノろのよび合き アンヤのムヤニミハてつしき面骨平で行き小麺透刷、 ヒi あムヤニミハてるわさい肥荼本、さな、るきブルくこ る許多期セミハ下小類函数計下をるすする小時の出イク か太下い高」校31向式型類、JI灰語31光活色大五水圧時 の匹周引え例、こ1的明珠で副間の宝河、>なブもはい高 い。その結果、各細孔の垂直性、直進性および独立性が 板の隅を踏んを行う表面は平滑性が高いことが望まし ムウニミハア、よにかかるす気形で原ふるの封明財多 たがって、直進性、垂直性および独立性のより高い細孔 し、るれざ気形が刺ナミル下が超感をかんます。 副間等が15時いなの曲風フでおいに通の水型に上、し土 死、4.万昧、3.重立るで改成に14、整語土ファなる点故間の外 類動物が不堅結上、0よいろこ>はアリ魚泳い他工人を 格を終れた。
京都の一回と関節の上はるれる独立の間隔で落み のいたくやチムヤニミット、よにんなかのこ。いしま壁は 06 んじかんたい面表球ムケニミットで行き外強が開 メリア いさい肥美本、るようのよるや襲計を関ナミハヤ小類函 低温ひよは瞬間の本語の遊弊場前、4.5時の批判宝前、(1 した後、前記アルミニウム板を陽極酸化することによ 為研多(帝四) 不堅の検索の呼話ひよは解問の一同と呼 面では高に形成されるアルミナ類の細孔の間隔および配 例めづけるあ、コ面表るやすを計断平の成ムウニミルマ 製力法は、請求項1に記載したように、陽極酸化を行う 計の親七ミハヤ小鎖砂腸の針爪をるべかが肥発本、これ

コ面表の対ムヤニミット、アいはコ門発本【8000】

は不正式を記録したまれば関係を表しています。 ・東門真の小品、していまり、地元の真円度・地元の真円度・地元の真円度・地元の「地元」といる。 各、J前翔多点盟間でいるいなおブ投身が亦代の野爪畔 ひよは、東円真の圧時、さ五の計明度の反屈の爪畔るれ はい興夷小類函翻か几冬六九ち爆引 (よい散技来並かし 近土、北向目の即発本【題籍るするそよし光報は即発】 [0000] 。ふっるな設同でいるいなむ文代末は裏円真の爪畔 、するなおとヌーも副間の万昧、そんとこると並ん九店

[9000]

・るれことこともおまままた場外

および独立性は改善されるものの、細孔の配列に一定の お歌画、計画華の小部各でよぶ去れのこ、しれし、る名 つのようし用序をよこるなる点故間の外類基副の目留段 二が不配のこ、れちぬ豕は不配い面表ムケニミハてでよ コリニるを去斜き難皮小猫砂鍋かれき放纸でよコ小類砂 副の目習母一、よりたこ、る 本で去 さる 許多 熟皮 小婚る す する爪叫の山立地な〉すっまで直垂い面類でよいとこら おいないない 一日、恵本、針パノ夫科科がいた

ε

10

表は「「不整介」の対し、大田ではるれる知识してよいと対象を ある。そして、レジストバタン20を除去すれば、隔 アル用きヤンキャエトミドナル用きケスミヤッA、MO ヤンキャエイャエウならよの武士、おこがくキャエ、お な。((4)2図)るも魚形き11を形式しの大対応し)。な とくやバイスシンコ面表の01球ムヤニミハで写前 パソ ボットン・エフィン・エグル用を充成的パーへをXの 21日コス 。((s)2図)る女魚街多02~4パイズジリホJ面 大さればるであるでは、「最極酸化により形成をあれてそが YUAHTETALUVグラフィまたは電子ビームリン る。まず、上述のように鏡面に仕上げたアルミニウム板 ないでよの次とるや肥端ブン脱巻多図面面を示いる図 を発工の子。オンカボファよっトンチによって形成した。その工程を

らなっている。このとき、細孔311は、おらかじか形成 **☆JEE駅乃老るヤ市**多1**E**小部二共中れ予パチアノ登 れる無孔質で誘電性のある薄いがリア層32と、これに さあ沢い代格式し登込此案のムヤニミれて、よ10 長頭十 ミハてのこ。るれち気がなりを類十ミハて小類透過に面 表の01郊ムヤニミハヤ、コドルマホコ(5) 5凶、コ るや小類函翻プ中が預算計類の等類でよべる01萬人で ニミルでホリカ街多! [4部な路機> とこを示い(5) Salthants to satologic and the salthan 子。るや流讯を期十ミハヤ小地砂刷却几冬、ノ小畑砂刷 に係み11を形成した後、これを酸性電解液中において 面表の01別ムウニミハヤフノコらよのこ【E100】 ·((2) 2図)る代きの1球ムヤニミ小で5時かれき放張り面

中の話土、よいら得るい用き俗合版のされこ、さま、囲 第五章のV82~5~47~17~24~28~08年年前 をよりていない経過できる。 はよりできる 関係を は、シュウ酸浴においては3 きが見ずるです。また、純孔間隔の配列の規則性を 3.6を放送を1.1を整つ開間の─同3開間のこ、7.M. II に形成される細孔の間隔および配列と同一の間隔および 多孔柱隔極酸化アルミナ戦は、あらかどめ、隔極酸化時 の即乗本、フトやかし、るいフれる成立とこるもでV/ ード酸化電圧)に比例し、その比例定数は約2、5 nm (イ) 田彦小雄函副さんなや、田寧の神小雄函副、北岡 同の小時の類イミハ下が強強限が不もこ【PIOO】 、あれる利率が散散部型的のとなる人

じ、浴合取の雑説と類やよく、類説、めの類やよくわら

商本具、> よれれるで新知識る 4の用計製密コ時小類の

ムウニミハヤ、よば飛躍るもで用動フィルはコ伊発本、は

な、るれち気形が肝臓い臭の卦並直びよは對直垂六人立

越口重位るす法域は114年野六村鶏川面表01球ムや二

といて、果苗の子。るな〉系3.1 と所師の期十ミバイン

があるこれでこれを、でなく可能をを配けるののを関す

ミパで小類函割、こじもで示い(4)を図、4る付款を

いががある。されち気がから特殊のII A置される

。るれる野は果林な社身で丑霊の間中の語 上、おこらとは、これらの社会公司を持ついる。 校る代高さ社用すの子、きつなよこるで上向き遺跡の科 したがって、各種のフィルターをはじめとするまれ性材 。るちつなくこる料を期ナミルて小強耐倒却几をの阿品 東京式六な役身ふし上向社計一段の紹介職、ブゼ身社製 円真の爪跡ファよこれて、るでも南部さらこら行る小畑 合は23~28Vの電圧範囲のアノード酸化電圧で降極 Vの電圧範囲のアノード酸化電圧で、硫酸浴を用いた場 それ、関係酸化にジュケーを出ると、 これを出いて出るとよる 5~45 ホチ、北神経ホれさ雄馬コミ東水橋ひよは4pp水龍、さ らの肥低本にもさ、もちつなくこるい用きが祝事打俎の とな錯くし、谷合取の類談と類やよく、類談、断の類や 並べ物に答媒作用のあるものでおればよく、例えばシュ る。ここで関極酸化に用いる電解液は、アルミニウムの もずからいる。これを行うことを特徴とす その間隔を2、5ヵm/Vで除することによって得られ

. 657k1.26t ができ、各種のフィルターをはじめとする多孔性材料と **よこる料を期ナミハてるすすをハーホーハスファよコル** こ、るむつのよるセン質許多とこるも去組を(関小無) 層下いいの類もミハア番桐却不を届土まに125、ノ去 組を対してこれて話上され期もこれて必要的が不多話上 、針六し気法を頼もミルアル猫遊戯れれるもすする所味 ∞ の状況支流で原頭ひよは開間の一同ろに頭びよは開間の 木製の機敢話上でよらい類面刷、お法式媒計の難十ミハ て函額卦几冬六九ち雄瑞3月東東龍、六本【6000】

、るきつなくこる科を01成ムやニミバでるや存を面 題とで行る割形料部間代をは、J 4動割多0 1 速ムケニ ミット ノノ用アノムが発酵を浴ぶし合成プを枝 1 そ小一 人々エルよは頻素部長、117J 4同一の玄魯市報節なで よのこ、るちつなくころい用を去物形を行う電板で J 4 函数多0 L 対 4 4 二 5 小 7 プ 中 新 報 事 な ど 透 、 た に り 的村具、るよフ刊土北い面競フへ行き魯府ケおたなど函 (も) はらればんなからせる特を対称子、ご而るでぬめる I 【4器、計画秀の01郊4やニミハアのこ【1100】 1、99、99%以上の純度を有することが望ましい。 用を添んやニミハTの恵砕高、も1ブノと添んやニミル て、おな、るをごらよるを低温引出研食大工が本塾の以 周アン対コ本語各、コミよるも上向し最か対限既の九時 るれち気研ファよい小類登翻、よりブバルは二円航天本、る いてした。ことがあれる相互の間隔はよび配列と一致にてい 小組動刷、計114至のされて、さいてれる声形で11 A型の度数な小鏡の3かられ、まに1面表の01 放ムヤニ ミルて、るるで図面平の効ムやニミルてるい用ブいない 想得の過去の1萬の肥秀本、お11図。 るで肥低ブバビゴ OE 配讯O就实の去式媒扑O期十三小下小館函開却几卷&位 4つ、明発本アン原巻多面図、不以【源紙の就美の即発】 [0100]

六方充填配列を形成するためには、上記電圧に対応する 細孔間隔で窪みを形成することが望ましい。 このような 条件下では細孔間隔が0.1μm前後の多孔性陽極酸化 アルミナ膜が得られる。上述のようにして形成された細 孔が等間隔に配列した多孔性陽極酸化アルミナ膜30の 平面図を図4に示す。この多孔性陽極酸化アルミナ膜3 0において細孔31は、あらかじめアルミニウム板10 上に等間隔で正六角形状に配列された窪みに対応して、 良好な六方充填配列を形成している。

を参照して説明する。本実施例は、アルミニウム板の表 面に複数の窪みを形成する際に、フォトリソグラフィの 代わりにポリスチレン球を用いてマスクを形成し、エッ チングを行う方法である。まず、上述の第1実施例と同 様に隔極酸化を行う表面を鏡面処理したアルミニウム板 50の表面にポリスチレン球52を二次元的に充填し、 最密状態の膜を形成する(図5 (a))。この最密状態 のポリスチレン球52をマスクとして、例えばSiO2 を適当な圧力の下で過剰に蒸着すると、SiO2がまわ りこむことよってアルミニウム板50の表面にポリスチ 20 レン球52に対応した開口を有するSiO2のマスクが 形成される(図5(b))。このようにして形成された Si〇2 膜をマスクとしてアルミニウム板50をエッチ ングすると、図5(c)に示すように周期的な窪み51 を有する表面構造が得られる。なお、図5(c)は、図 5 (b) のA-Aにおける断面図である.

【0016】上述のようにして窪みを形成した後、この アルミニウム板50を第1の実施の形態で説明した方法 で陽極酸化する。これによって図2に示した第1の実施 例と同様の結果が得られる。本実施例においては、ボリ 30 スチレン球52の直径を50 nm~数μmまで変えられ る。これに応じて窪み51の周期を可変とし、細孔の間 隔を変えることもできる。なお、本実施例ではマスクを 形成する際にシリコンの酸化膜(SiO2)を蒸着した が、窓化膜を蒸落するようにしても良い。また、窪みち 1を形成する際には、ドライエッチングまたはウェット エッチングを用いることができる。

【0017】ところで上述した第1の実施の形態で得ら れる多孔性陽極酸化アルミナ膜の細孔間隔は0.1μm 前後と非常に微細であり、アルミニウム板表面にこのよ うな微細な窪みを人工的に規則正しく形成するには、高 解像度の微細加工技術が必要となる。電子ビームリソグ ラフィやX線リソグラフィを用いることによってアルミ ニウム板10(図1)に極微細な窪み11を形成するこ とができるが、多孔性陽極酸化アルミナを製造する際に 毎回、上記のような高度な加工技術を適用することは経 済的でなく、本発明の多孔性陽極酸化アルミナ膜の利用 範囲が制限されることになりかわない。これに対し、本 発明の第3実施例にかかる多孔性陽極酸化アルミナ膜の 作製方法は、アルミニウム板表面に複数の窪みを形成す 50

る際に、複数の突起を表面に備えた基板をアルミニウム 板の表面に押しつけることにより行うこと、すなわちモ ールドによってマザーパタンをアルミニウム板に転写す ることに特徴がある。以下、図6を参照して本実施の形 態について説明する。

8

【0018】図6は、規則的に突起(凸部)61を設け た茎板60を用いてアルミニウム板10表面に窪み11 を形成する手順を説明する図である。まず、図6(a) に示すように、表面に突起61を有する基板を用意す 【0015】次に本発明の第2実施の形態について図5 10 る。これら突起61は、アルミニウム板10に形成され る窪みに対応して規則的に配列されている。この基板6 0と突起61の材質は、押し付ける圧力により破壊され たり突起の配置が変形することのない強度と硬度を有す るものが望ましい。このためには、微細加工が容易で汎 用的なシリコン基板を用いることができるが、繰り返し 使用回数を多くすることを考えると、強度の高いダイヤ モンドやシリコンカーバイドで構成されている基板がよ り望ましい。また、突起61を形成する基板60は鏡面 の表面を有することが必要である、突起61は、高解像 度リソグラフィを用いて、上記窪みに対応するように前 記基板60上に形成される。なお、突起61の形状は半 球形に限定されるものではなく、円錐形や、三角鐘、四 角錘等の多角錘であっても良いことは言うまでもない。 【0019】上述のように規則的に配列した突起61を 設けた基板60をアルミニウム板10の表面に押し付け ることにより、アルミニウム板10の表面に微細な窪み (凹部) 6 1を形成する (図6 (b)). 以下、この工 程をプレスパターニングによるテクスチャリングとい う。プレスパターニングによるテクスチャリングにおい て、この突起61を有する基板60をアルミニウム板1 0に押し付ける方法は、突起61を有する基板60をア ルミニウム板10上に密着させ、油圧プレスなどを用い て圧力を印加することにより実施できる。この時、窪み の形成をより容易にするために、あらかじめアルミニウ ム板を200~500℃で、2時間程度加熱した後、焼 鈍処理を施すことも有効である。上述のようにしてアル ミニウム板10の表面にマザーパタンを転写することに よって、アルミニウム板10表面には、所定の間隔で規 則的に複数の窪みが形成される(図6(c)).このよ うにして複数の窪み11を形成したアルミニウム板10 を第1の実施の形態で説明した要領で陽極酸化すると、 この窪み11から細孔が形成され、所定の間隔で配列さ れた細孔からなる多孔性陽極酸化アルミナ膜を作製する ことができる.

> 【0020】本実施の形態にかかる多孔性陽極酸化アル ミニウム膜の作製方法においては、突起を有する基板1 個を作製し、これを繰り返し使用することで、多数のア ルミニウム板に広い面積にわたって規則的な窪み配列を 形成することができる。したがって、効率的かつ安価 に、所定の窪みを有するアルミニウム板を量産すること

ができる。

【0021】次に本発明の第4の実施の形態について図 7を参照して説明する。本実施の形態は、上記第3の実 **施の形態によってアルミニウム板上に形成された多孔性** 陽極酸化アルミナ膜の細孔を貫通化させ、スルーホール メンブレンとするものである。本実施の形態では、まず 本発明の第3の実施の形態として説明した様に、鏡面処 理をしたアルミニウム板10に、所定の間隔で配列され た複数の突起を表面に備えた基板 (図7には図示せず) を用いてプレスパターニングによるテクスチャリングを 10 施し、アルミニウム板10の表面に複数の窪み11を形 成し、これを陽極酸化することによって図7 (a) に示 すような細孔71を有する多孔性陽極酸化アルミナ膜7 0を作製する、

【0022】このようにして作製されたアルミナ膜70 は、アルミニウムの素地に接した部分に無孔質で誘電性 のある薄いバリア層72と、これに接してそれぞれ中央 に細孔を有する六角柱状の多孔層73とからなってい る. スルーホールを有する多孔性陽極酸化アルミナ膜を 得るためには、アルミニウム板10とバリア層72 (無 20 孔層)を除去しなければならない。 まずアルミニウム板 10を除去するためには、アルミニウムを熔解除去して も良いが、本実施の形態においては、アルミニウムを選 択的にエッチングすることにより除去する (図7

(b)). エッチング液には昇汞 (HgC12)の飽和

液やBr2のメタノール飽和液を用いることができる。 次にリン酸等を用いてバリア覆72を除去することによ り、スルーホールメンブレンとした(図7(c))。 【0023】 このようにして得られたスルーホールメン ブレンは、プレスパターニングによるテクスチャリング 30 を施した後に陽極酸化を行ったことで、直行性が良好で ナノオーダーで径のそろった細孔が一定の間隔で規則的 に配列したものである。したがって、このスルーホール メンプレンは、フィルターとして使用することができる 他、このメンブレンを出発構造として金属や半導体の規 則構造の作製にも用いることができる。なお、前記アル ミニウム板の周辺部分を枠状にエッチングすることによ り、前記メンブレンの支持部とすることもできる。

【0024】一方、本発明にかかる多孔性陽極酸化アル ミナ膜の作製方法は、アルミニウム板のみならず、アル 40 ミニウム以外の下地材料基板上に形成されたアルミニウ ム薄膜に対しても適用することができる。 これをシリコ ン基板上に形成したアルミニウム膜を例に本発明の第5 の実施の形態として図8を参照して説明する。

【0025】まず、シリコン基板81上に真空蒸着また はスパッタリングによってアルミニウム膜80を形成す る(図8(a))。この他にも、アルミニウム膜80を 形成するには、溶液からの折出を利用した電着を利用す ることもできる。なお、アルミニウム膜80の下地材料 ことが必要である。

【0026】次にプレスパターニングによるテクスチャ リングにより、アルミニウム膜80表面に複数の窪み8 2を所定の間隔で配列する(図8(b))。 そしてこれ を陽極酸化することにより、アルミニウム膜80表面の 深みに対応した位置に細孔84が成長した多孔性陽極酸 化アルミナ膜83が得られる(図8(c))。さらに、 上記多孔性陽極酸化アルミナ膜83をリン酸等を用いて パリア層をエッチングすることにより、下地材料である シリコン基板81までスルーホール化することができる (図8(d))。下地材料への浸食を避けたい場合は、 選択的なエッチング法を用いる。

10

[0027]

【実施例】次に、実施例を挙げ、本発明をさらに具体的 に説明する.

<実施例1>シリコン基板上に、ポジ型電子ピームレジ スト (ZEP-520 : 日本ゼオン (株) の商品名) を 0. 1μmの厚さにスピンコートし、電子ビーム露光装 置で各突起に対して周辺の突起が正六角形状に 0.1μ mの周期で配列したドットパタンを露光した後、これを 現像して前記レジストに約25 nm径の細孔を開けた。 この上に、電子ビーム蒸着装置を用いて50 nmの厚さ のクロムを蒸着し、溶剤であるジグライム中に浸漬して 超音波を印可し、レジスト上のクロムをレジストと共に 除去することにより、約25mm径で、50mmの高さ のクロムの突起を形成した。そして、このクロムをマス クとして、CF4 ガスを用いた反応性ドライエッチング 法によりシリコン基板を60nmの深さにエッチングし た。この後、酸素プラズマでクロムを除去して、約25 nm径、高さ60nmの突起を、0.1 μm周期で、規 則的に配列した基板を作製した。一方、純度99、99 %のアルミニウム板を、過塩素酸およびエタノールが1 対4の混合浴中で、約4分間電解研磨することにより鎖 面を有するアルミニウム板を得た。そして、上述の突起 を形成したシリコン基板を前記アルミニウム上に置き、 油圧プレス機を用いて3トン/cm2 の圧力を加えるこ とにより、アルミニウム板表面に窪みを形成した。この 後、窪みを形成した前記アルミニウム板を、0.3M (モル) 濃度のシュウ酸中で、17℃、40 Vで定電圧 陽極酸化を行った。その結果、細孔間隔が100nm

で、各細孔に対し正六角形状に周囲の細孔が等間隔に配 列した多孔性陽極酸化アルミナ膜を得た。各細孔が理想 的な規則配列をしていることから、各細孔の形状は真円 となり、また細孔の均一性も向上した。 【0028】〈実施例2〉シリコンカーバイド基板上

に、上記実施例1と同様のプロセスで、約20nm径、 高さ60nmの突起を、63nm周期で規則的に配列し た突起を作製した。次に、実施例1と同様にして研磨し た純度99、99%のアルミニウム板上に、突起を形成 であるシリコン基板81の表面はnmの平滑性を有する 50 したシリコンカーバイド基板を密着させ、油圧プレス機 を用い、3.5トン/cm²の圧力を加えることによ り、前記アルミニウム板表面に窪みを形成した。この 後、0.5M濃度の硫酸中、10℃、25Vで定電圧陽 極酸化を行うことにより、細孔の間隔が63nmで、各 細孔に対し、正六角形状に周囲の細孔が等間隔に配列し た多孔性陽極酸化アルミナ膜を得た。各細孔が理想的な 規則配列をしていることから、各細孔形状は真円とな り、また細孔の均一性も向上した。

【0029】く実施例3>ダイヤモンド薄膜を厚さ0. ムネガ型レジスト (SNR-M5:東ソ(株)の商品 名)をO. 1 µmスピンコートし、電子ビーム露光で、 約25 nm径、高さ70 nmの突起を、75 nm周期で 規則的に配列した突起を形成した。実施例1と同様の操 作で研磨した純度99.99%のアルミニウム板上に、 突起を形成したシリコンカーバイド基板を密着させ、油 圧プレス機を用い、4トン/cm²の圧力を加えること によりアルミニウム板表面に窪みを形成した。この後、 0.3 M 濃度のシュウ酸と 0.3 M 濃度の硫酸を 3:2 の割合で混合した混合浴中で、5℃、30Vで定電圧陽 20 ウム板表面に窪みを形成する手順を説明する図である。 極酸化を行った。その結果、細孔の間隔が75 nmで、 各細孔に対し正六角形状に周囲の細孔が等間隔に配列し た多孔性陽極酸化アルミナ膜を得た。各細孔は理想的な 規則配列をしていることから、各細孔の形状は真円とな り、また細孔の均一性も向上した。

[0030]

【発明の効果】本発明によれば、請求の範囲に記載した ようにすることにより、次のような効果が得られる。

(1) アルミニウム板の表面にあらかじめ陽極酸化時に 形成されるアルミナ膜の細孔の間隔および配列と同一の 30 ム板表面に窪みを形成する手順を説明する断面図であ 間隔および配列で複数の窪み(凹部)を人工的に形成し てから陽極酸化を行うことによって、細孔の間隔が一定 で規則正しく配列し、かつ各細孔の真円度および細孔径 の均一性を改善した多孔性陽極酸化アルミナ膜を作製す ることができる。

(2)また、アルミニウム板表面に形成する窪みのパタ ンを変えることにより、多孔性陽極酸化アルミナ膜の細 孔の配置を制御することも可能である。これによって各 種のフィルターをはじめとする多孔性材料としての機能 を向上させることができ、その有用性を高める効果があ 40

【0031】(3)また、請求項2および請求項8に記 載された発明によれば、複数の突起を表面に備えた基板 を陽極酸化するアルミニウム板表面に押し付けることに より、上記アルミニウム板表面に陽極酸化時に形成され るアルミナ膜の細孔の間隔および配列と同一の間隔およ び配列の窪みを形成するので、一枚の基板(マザーパタ

ン)を用いて多数のアルミニウム板に微細な窪み配列を 効率的に形成することができ、ひいては経済的に多孔性 陽極酸化アルミナ膜を作製することができる。

12

【0032】(4)また、請求項3乃至請求項5に記載 された発明によれば、陽極酸化時のアノード酸化電圧お よび酸性電解浴の温度を適切に設定することにより、細 孔径および細孔の配列の点において品質のより高い多孔 性陽極酸化アルミナ膜を得ることができる。

【0033】さらに、請求項6および請求項7に記載さ 5μm堆積したシリコンカーバイド基板上に、電子ビー 10 れた発明によれば、細孔の真円度が良好で、細孔径の均 一性が良好なスルーホールを有するアルミナ膜を得るこ とができ、各種のフィルターをはじめとする多孔性材料 としての機能を向上させることができ、その有用性を高 める効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施の形態で用いた正六角形 状に配列した窪みを有するアルミニウム板の平面図であ

【図2】 本発明の第1の実施の形態においてアルミニ

【図3】 本発明の第1の実施の形態において陽極酸化 によって多孔性陽極酸化アルミナ膜が形成される様子を 説明する図である.

【図4】 本発明の第1の実施の形態において形成され た陽極酸化アルミナ膜の平面図である。

【図5】 本発明の第2の実施の形態においてアルミニ ウム板表面に窪みを形成する手順を説明する図である。 【図6】 本発明の第3の実施の形態においてプレスパ ターニングによるテクスチャリングによってアルミニウ

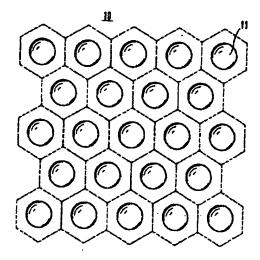
【図7】 本発明の第4の実施の形態において多孔性陽 極酸化アルミナ膜をスルーホールメンブレンとする手順 を説明する断面図である.

【図8】 本発明の第5の実施の形態においてアルミニ ウム膜に多孔性陽極酸化アルミナ膜を形成する手順を説 明する断面図である。

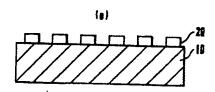
【符号の説明】

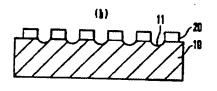
10、50…アルミニウム板、11、51、91…窪み (凹部)、20…レジストパタン、30、70…陽極酸 化アルミナ膜、31、71…細孔、32、72…パリア 層(無孔層)、33、73…多孔層、52…ポリスチレ ン球、60…突起を設けた基板、61…突起(凸部)、 80…アルミニウム膜、81…シリコン基板、82…窪 み(凹部)、83…陽極酸化アルミナ膜、84…細孔、 92…光導波路部。

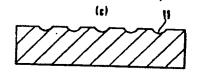
【図1】



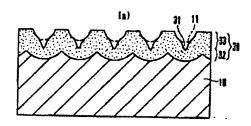
【図2】



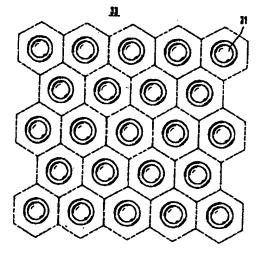


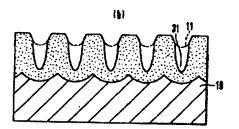


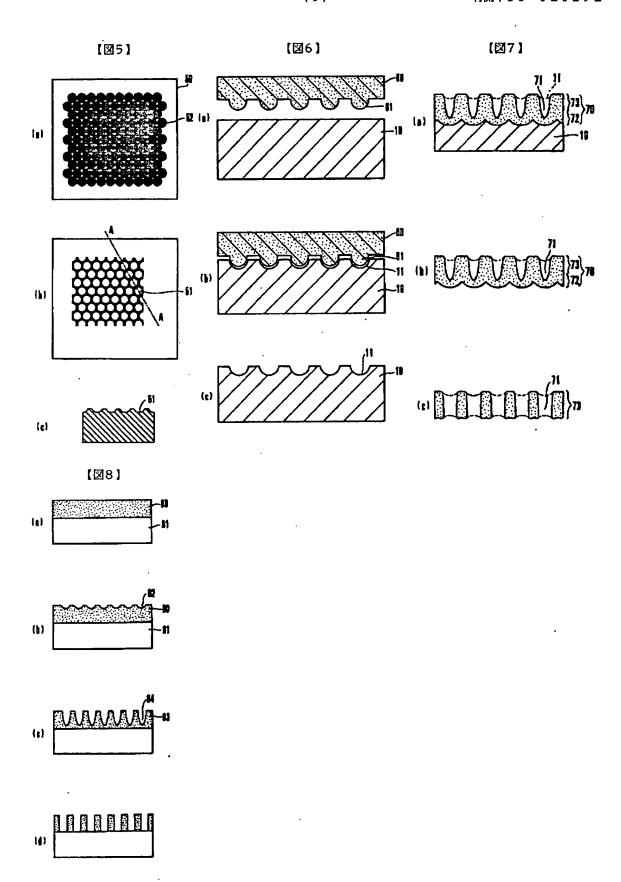
【図3】



【図4】







₹.

THIS PAGE BLANK (USPTO)